

2SD836, 2SD836A

シリコン NPN 三重拡散プレーナ形ダーリントン
Si NPN Triple Diffused Planar Darlington

低周波電力増幅／AF Power Amplifier

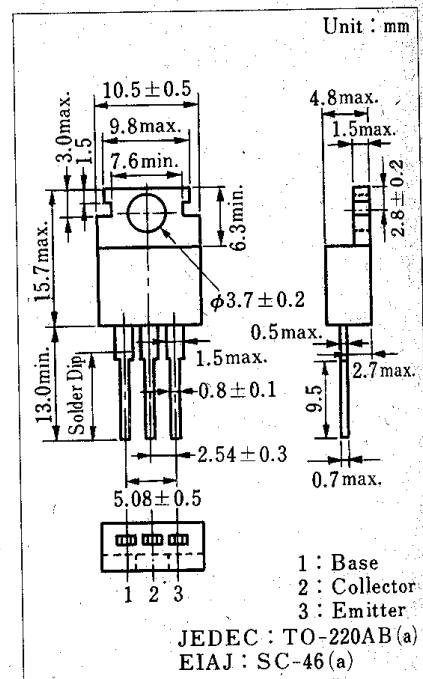
2SB750, 2SB750A とコンプリメンタリ／Complementary Pair
with 2SB750, 2SB750A

■ 特 徴／Features

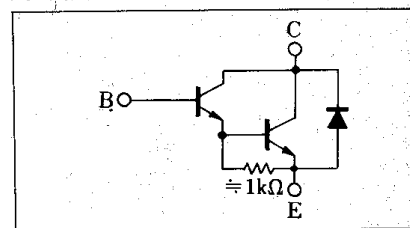
- 直流電流増幅率 h_{FE} が高い。／High h_{FE}
- スイッチング速度が速い。／High speed switching

■ 絶対最大定格／Absolute Maximum Ratings ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

Item	Symbol	Value	Unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	60	V
		80	
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	60	V
		80	
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	5	V
せん頭コレクタ電流	I_{CP}	4	A
コレクタ電流	I_C	2	A
コレクタ損失 ($T_c = 25^\circ\text{C}$)	P_C	35	W
接合部温度	T_j	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	$-55 \sim +150$	$^\circ\text{C}$



内部接続図／Connection Diagram



■ 電気的特性／Electrical Characteristics ($T_c = 25^\circ\text{C}$)

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタ・シャ断電流	I_{CBO}	$V_{CB} = 60\text{ V}, I_E = 0$			1	mA
		$V_{CB} = 80\text{ V}, I_E = 0$			1	
コレクタ・シャ断電流	I_{CEO}	$V_{CE} = 30\text{ V}, I_B = 0$			2	mA
		$V_{CE} = 40\text{ V}, I_B = 0$			2	
エミッタ・シャ断電流	I_{EBO}	$V_{EB} = 5\text{ V}, I_C = 0$			2	mA
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	$I_C = 30\text{ mA}, I_B = 0$	60			V
			80			
直流電流増幅率	h_{FE1}	$V_{CE} = 4\text{ V}, I_C = 1\text{ A}$	1000			
	h_{FE2}^*	$V_{CE} = 4\text{ V}, I_C = 2\text{ A}$	1000		10000	
ベース・エミッタ電圧	V_{BE}	$V_{CE} = 4\text{ V}, I_C = 2\text{ A}$			2.8	V
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = 2\text{ A}, I_B = 8\text{ mA}$			2.5	V
ターンオン時間	t_{on}	$I_C = 2\text{ A}, I_{B1} = I_{B1} = 8\text{ mA}, I_{B2} = -8\text{ mA}$		0.4		μs
ターンオフ時間	t_{off}			4		μs

* h_{FE2} ランク分類／ h_{FE2} Classifications

Class	R	Q	P
h_{FE2}	1000 ~ 2500	2000 ~ 5000	4000 ~ 10000